

- Чт 47** С.В. Тихов, О.Н. Горшков, А.П. Касаткин, И.Н. Антонов, М.Н. Коряжкина
Особенности поведения МДП-структур на основе эпитаксиальных слоев с пассивированной нанослоем InP поверхностью GaAs
- Чт 48** А.Р. Туктамышев, В.А. Тимофеев, В.И. Машанов, А.И. Никифоров, М.Ю. Есин
Начальные стадии роста тройных сплавов Si-Ge-Sn на Si(100), выращенных методом низкотемпературной МЛЭ
- Чт 49** В.И. Ушанов, В.В. Чалдышев, Н.А. Берт, В.Н. Неведомский, Н.Д. Ильинская, Н.М. Лебедева, М.А. Яговкина, В.В. Преображенский, М.А. Путьто, Б.Р. Семягин
Плазмонный резонанс в новых металло-полупроводниковых метаматериалах AsSb-AlGaAs
- Чт 50** Е.В. Фролова, Н.А. Кравец
Циклотронная динамика электронных волновых пакетов в топологических диэлектриках, находящихся во внешнем магнитном поле
- Чт 51** С.В. Хазанова, В.Е. Дегтярев, Н.В. Байдушь
Исследование электрофизических и транспортных свойств гетероструктур InGaAs/GaAs с δ -легированием
- Чт 52** С.В. Хазанова, В.Е. Дегтярев, Н.В. Демарина
Энергетический спектр электронов в InAs квантовых нитях с поперечным сечением реальной формы
- Чт 53** Д.В. Хомицкий, А.А. Чубанов, А.А. Конаков
Электронные состояния с управляемой локализацией в двойной квантовой точке с магнитными барьерами на краю топологического изолятора
- Чт 54** О.И. Хрыкин, Ю.Н. Дроздов, М.Н. Дроздов, П.А. Юнин, В.И. Шашкин, С.А. Богданов, А.Б. Мучников, А.Л. Вихарев, Д.Б. Радищев
Монокристаллические слои GaN/AlN на подложке нанокристаллического CVD алмаза
- Чт 55** М.Е. Шенина, О.Н. Горшков, М.Н. Коряжкина, А.П. Касаткин
Формирование металлических наночастиц в стабилизированном диоксиде циркония при имплантации ионов Ag
- Чт 56** П.А. Юнин, М.Н. Дроздов, С.А. Королев, А.И. Охапкин, О.И. Хрыкин, В.И. Шашкин
Слой CVD Si₃N₄ для *in situ* пассивации транзисторных структур на основе GaN
- Чт 57** А.В. Антонов, М.Н. Дроздов, А.В. Новиков, Д.В. Юрасов
Исследование сегрегации Sb в Ge слоях, выращенных методом МПЭ